

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 S1XT452N	文件编号	XS-R-089
	瞬态电压抑制 (TVS) 二极管	版本号	19-A1-04
		页码	1/3

1 主要用途与主要特点

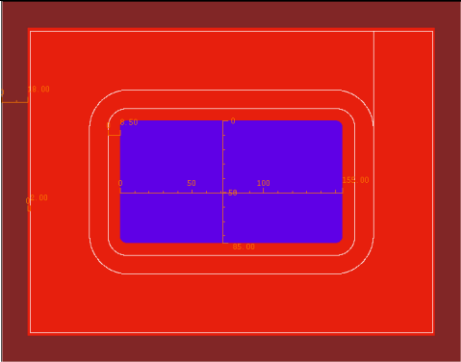
1.1 主要用途

用 S1XT452N 封装的成品管主要用于便携式电子产品中电源端的 ESD 保护。

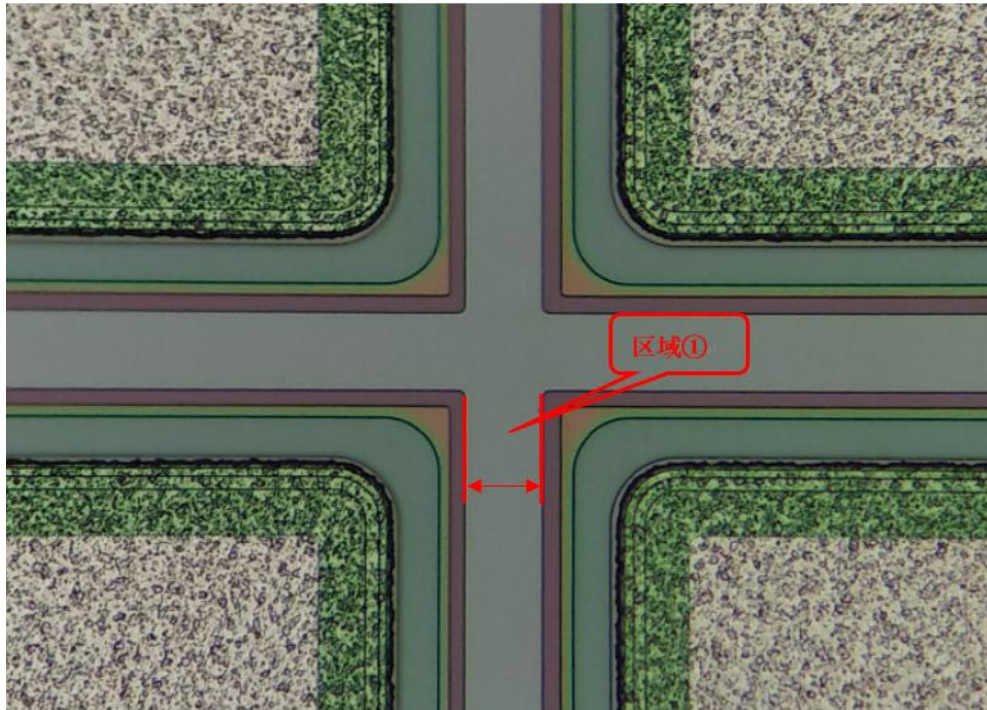
1.2 主要特点

- 低反向漏电
- 高静电防护能力
- 高可靠性

2 芯片数据

	芯片尺寸 (mm×mm)		0.32×0.25	
	芯片厚度 (μm) (推荐)		≤170	
	理论管芯数		204839	
	划片道*尺寸 (μm)		40	
	键合区面积 (μm ²)	正面	159×89	
		金属	铝	
	正面电极	厚度 (μm)	5.0±1.0	
		背面电极	表层金属	银
	装片要求 (推荐)		低温共晶	共晶
	硅片直径 (mm)		φ150	
键合要求 (推荐)		铜丝; φ22 μm; 1 根		

* 划片道位置示意图:



备注: 区域①为划片道区域, 宽度为 40μm。


江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: <http://www.xs-elec.com>

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 S1XT452N	文件编号	XS-R-089
	瞬态电压抑制 (TVS) 二极管	版本号	19-A1-04
		页码	2/3

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

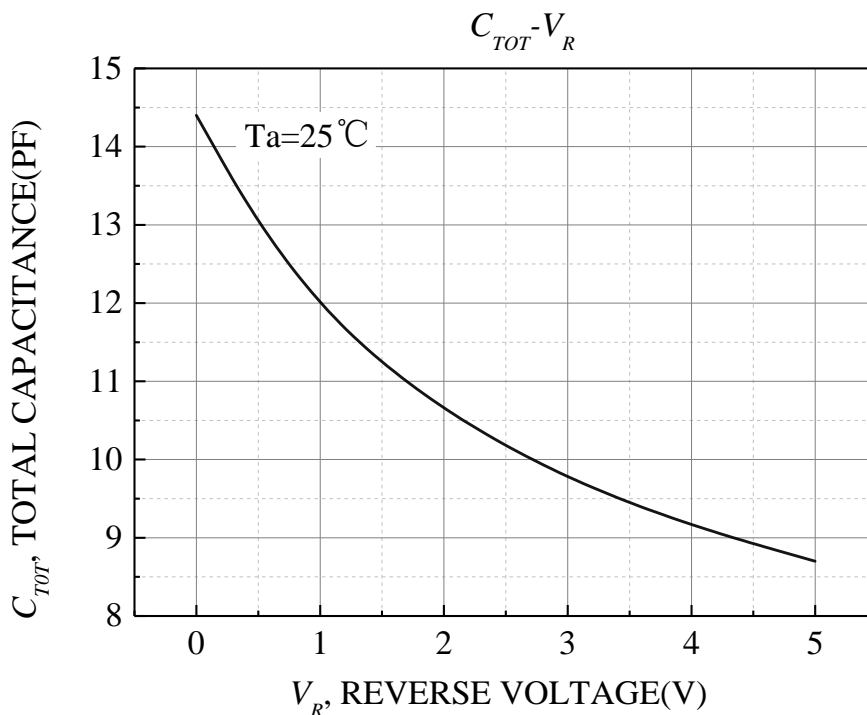
参数名称	符号	额定值	单位	备注
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	推荐封装形式: SOD-523 推荐成品: CESDBLC5V0D5
贮存温度	T_{stg}	-40~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	V_{BR}	$I_z = \pm 1\text{mA}$	5.5	7.2	8.5	V
反向电流	I_R	$V_R = \pm 5\text{V}$	—	—	1	μA
结电容	C_{tot}	$V_R = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$	—	14.5	—	pF
反向峰值电压	V_{C1}	$I_{P1} = \pm 5\text{A} (8 \times 20\mu\text{s waveform})$	—	—	12.5	V
反向峰值电压	V_{C2}	$I_{P2} = \pm 8\text{A} (8 \times 20\mu\text{s waveform})$	—	—	15	V

3.3 典型特性曲线




江阴新顺微电子有限公司

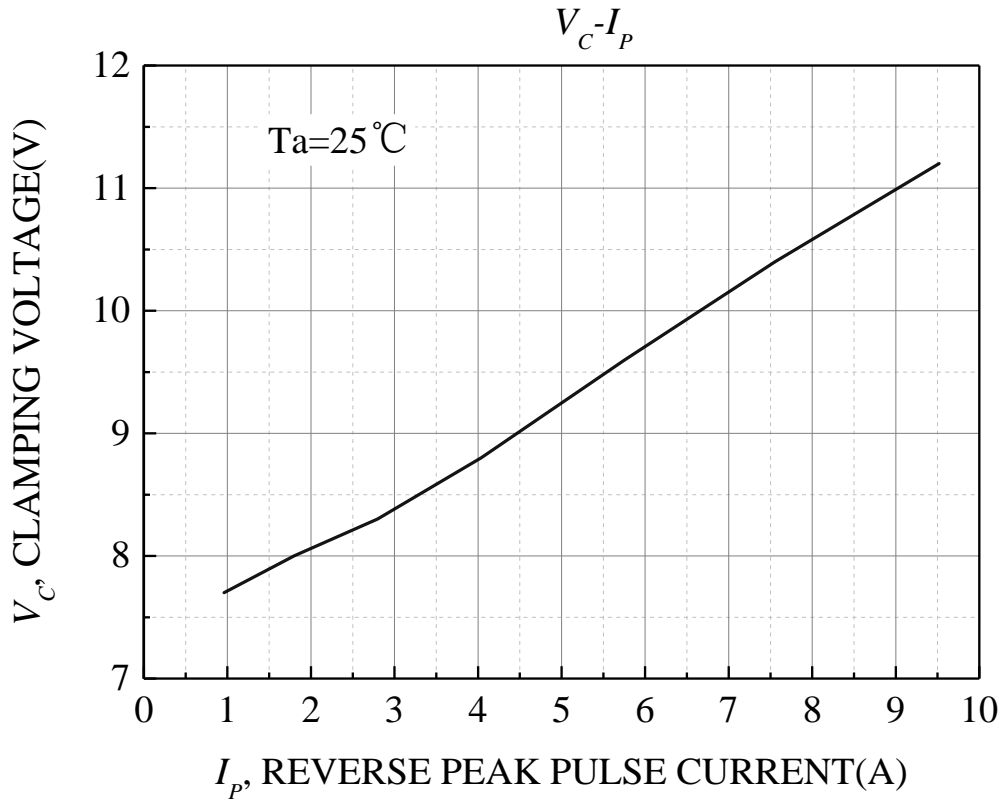
地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: <http://www.xs-elec.com>

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 S1XT452N	文件编号	XS-R-089
	瞬态电压抑制 (TVS) 二极管	版本号	19-A1-04
		页码	3/3



注意事项:

- 芯片存储条件 (推荐): 氮气保护, 温度 $25 \pm 5^\circ\text{C}$, 湿度 $\leq 45\%$;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地 址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网 址: <http://www.xs-elec.com>

电 话: (0510) 86851182

传 真: (0510) 86851532